メタライゼーション

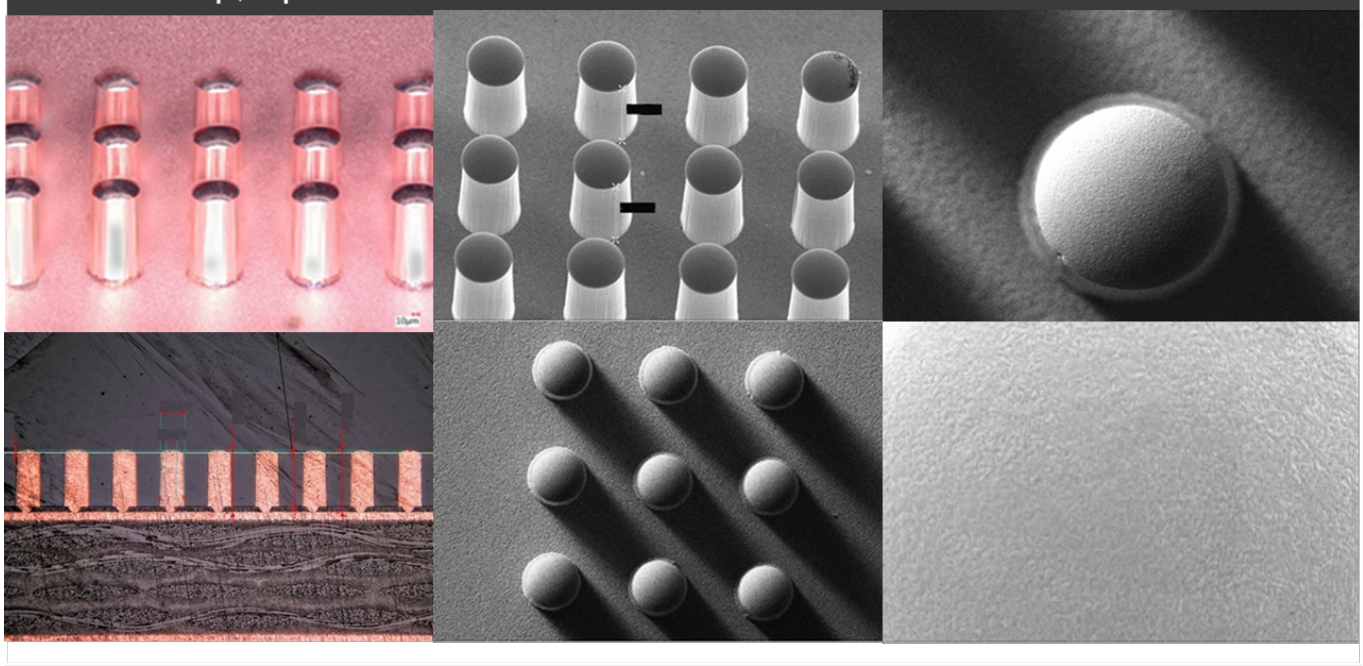
Cu Pillar Plating

Cu Pillar Platingプロセス Systek BMP-LP8

半導体向け硫酸銅めっきのリーディングカンパニーであるMacDermid EnthoneがPLP（Panel Level Packaging）向けの高速Cu Pillarめっきプロセスを開発しました。

特徴

- DC硫酸銅めっき
- ピラー径　　80～200μm
- ピラー高さ　100～200μm
- 高電流密度による高速めっき対応　15A/dm2以上に対応
- 高純度銅析出
- CVS法による添加剤分析

Anode type	Product	Sample info.		Current Density	Plating Time	Target thickness
		Temp.	D/F thickness			
Inert	SYSTEK BMP LP8	40C	200 um	18 ASD	60 min	200 um

Dome bump, 8 μm